

а 2005 0168

Изобретение относится к полупроводниковой технике, в частности к тонкослойным солнечным ячейкам.

Тонкослойная солнечная ячейка на основе бинарных соединений A^2B^6 , включает последовательно нанесенные на подложку один на другой передний омический контакт, широкозонный полупроводниковый тонкий слой, узкозонный полупроводниковый тонкий слой и тыльный омический контакт. Новизна изобретения состоит в том, что солнечная ячейка дополнительно содержит неметаллический тонкий слой, расположенный между узкозонным полупроводниковым тонким слоем и тыльным омическим контактом.

П. формулы: 1

Фиг.: 3